

電磁理論IB (Aクラス) 期末試験 173	2009年7月24日	学籍番号	氏名	評点
---------------------------	------------	------	----	----

1. 真空中に一様電荷密度 ρ で満たされた半径 a の円柱状の静止電荷分布がある。表面電荷密度 $\xi = 0$ とする。以下に答えよ。

(1-1) 電束に関するガウスの法則(積分形)を記述し、その物理的意味を記述せよ。

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{m} dS = \int_V \rho dV \quad (\text{or } \oint_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{m} dS = \int_V \rho dV)$$

空間の任意の閉曲面 S を通って、その領域 V が外方に出ていく
正味の電束(左辺)は領域 V 内に含まれる正味の(正)電荷量(右辺)に等しい。

(1-2) 電束に関するガウスの法則を示す積分形の方程式から微分形を導け。

電束に関するガウスの法則を示す積分形は

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{m} dS = \int_V \rho dV \quad (\text{or } \oint_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{m} dS = \int_V \rho dV)$$

ガウスの発散定理より

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{m} dS = \int_V \nabla \cdot \mathbf{D} dV = \int_V \rho dV \quad \therefore \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$(\text{or } \nabla \cdot \epsilon_0 \mathbf{E} = \rho)$$

(1-3) 上記のマクスウェル方程式(微分形)を用いて円柱内外の電界 E を求めるとき、解くべき微分方程式と境界条件を求めよ。

円柱座標系 (r, φ, z) において

$$\nabla \cdot \epsilon_0 \mathbf{E} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(\epsilon_0 E_r r)}{\partial r} + \frac{\partial(\epsilon_0 E_\varphi)}{\partial \varphi} + \frac{\partial(\epsilon_0 E_z)}{\partial z} \right] = \frac{1}{r} \frac{\partial(r \epsilon_0 E_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\epsilon_0 E_\varphi)}{\partial \varphi} + \frac{\partial(\epsilon_0 E_z)}{\partial z} = \begin{cases} \rho & (r < a) \\ 0 & (r > a) \end{cases}$$

系の対称性より $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$ z 方向無限長一様より $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ E は r 方向成分 E_r のみ $\therefore$ 解くべき微分方程式は

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(r \epsilon_0 E_r)}{\partial r} = \begin{cases} \rho & r < a \\ 0 & r > a \end{cases}$$

$r = a$ の境界面に表面電荷 $\xi = 0$ で存在しないので $\therefore E$ の法線成分すなわち E_r は $r = a$ で連続。

$$\text{境界条件 } m \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = m \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E}_1 - \epsilon_0 \mathbf{E}_2) = \xi = 0$$

(1-4) (1-3)より円柱内外の電界 E を求めよ。また $|E|$ の半径方向の分布を図示せよ。尚、積分形から求めても良い。

i) $r < a$ の場合

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(r \epsilon_0 E_r)}{\partial r} = \rho \quad \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(r \epsilon_0 E_r)}{\partial r} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial r}(r \epsilon_0 E_r) = \rho r \quad \left(\frac{\partial}{\partial r}(r \epsilon_0 E_r) = \frac{\rho}{\epsilon_0} r \right)$$

$$\therefore r \epsilon_0 E_r = \frac{1}{2} \rho r^2 + C_1 \quad (r E_r = \frac{\rho}{2 \epsilon_0} r^2 + C_1)$$

$$\therefore E_r = \frac{\rho}{2 \epsilon_0} r + \frac{C_1}{\epsilon_0 r} \quad (E_r = \frac{\rho}{2 \epsilon_0} r + \frac{C_1}{r}) \quad \text{①'}$$

$r = 0$ で E_r は有界より $C_1 = 0$

$$\therefore E_r = \frac{\rho}{2 \epsilon_0} r \quad \text{--- ②}$$

ii) $r > a$ の場合

$$\frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r}(r \epsilon_0 E_r) \right) = 0 \quad \therefore \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r \epsilon_0 E_r) = 0$$

$$\therefore \frac{\partial}{\partial r}(r \epsilon_0 E_r) = 0 \quad \therefore r \epsilon_0 E_r = C_2$$

$$\therefore E_r = \frac{C_2}{r} \quad \text{--- ③}$$

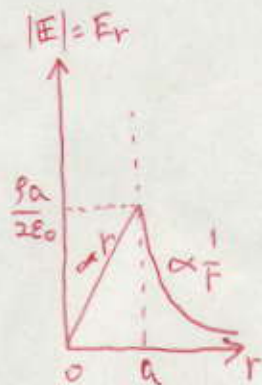
②③に(1-3)の境界条件を適用して

$$E_r(r=a) = \frac{\rho}{2 \epsilon_0} a = \frac{C_2}{a}$$

$$\therefore C_2 = \frac{\rho a^2}{2 \epsilon_0} \quad \text{--- ④}$$

$$\therefore E_r = \begin{cases} \frac{\rho}{2 \epsilon_0} r & r < a \\ \frac{\rho a^2}{2 \epsilon_0} \frac{1}{r} & r > a \end{cases}$$

$$\therefore \mathbf{E} = \begin{cases} \hat{\mathbf{r}} \frac{\rho}{2 \epsilon_0} r & (r < a) \\ \hat{\mathbf{r}} \frac{\rho a^2}{2 \epsilon_0} \frac{1}{r} & (r > a) \end{cases}$$



(1-4) 別解: 積分形を用いた方法 2 方向単位長 1 1 参考

$$\oint_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \rho dV$$

$$n dS = d\mathbf{r} = d\mathbf{r}_\varphi \times d\mathbf{r}_z = \hat{\mathbf{r}}_\varphi r d\varphi \times \hat{\mathbf{r}}_z dz = \hat{\mathbf{r}}_\varphi \times \hat{\mathbf{r}}_z r d\varphi dz = \hat{\mathbf{r}}_r r d\varphi dz$$

$$dV = d\mathbf{r} \cdot (d\mathbf{r}_\varphi \times d\mathbf{r}_z) = r dr d\varphi dz$$

$$\therefore \int_0^{2\pi} \int_0^1 \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{r}}_r r d\varphi dz = \begin{cases} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^r \rho r dr d\varphi dz & r < a \\ \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^a \rho r dr d\varphi dz & r > a \end{cases}$$

円柱対称性より

$$\mathbf{E} \text{ は } r \text{ 方向成分 } E_r \text{ のみ } \therefore \mathbf{E} = \hat{\mathbf{r}}_r E_r$$

$$\epsilon_0 E_r r [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^1 = \begin{cases} \rho [\frac{1}{2} r^2]_0^r [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^1 & (r < a) \\ \rho [\frac{1}{2} r^2]_0^a [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^1 & (r \geq a) \end{cases}$$

$$\therefore \epsilon_0 E_r 2\pi r = \begin{cases} \rho \frac{1}{2} r^2 \cdot 2\pi \cdot 1 & r < a \\ \rho \frac{1}{2} a^2 \cdot 2\pi \cdot 1 & r \geq a \end{cases}$$

$$\therefore E_r = \begin{cases} \frac{\rho}{2\epsilon_0} r & r < a \\ \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{r} & r \geq a \end{cases} \quad \therefore \mathbf{E} = \begin{cases} \hat{\mathbf{r}}_r \frac{\rho}{2\epsilon_0} r & r < a \\ \hat{\mathbf{r}}_r \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{r} & r \geq a \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{(答)} \text{ 単位長に当り全電荷: } Q = \pi a^2 \rho \cdot 1 \quad \therefore \rho = \frac{Q}{\pi a^2} \\ \therefore E_r = \begin{cases} \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 a^2} r & (r < a) \\ \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 r} & (r \geq a) \end{cases} \end{array} \right)$$

電磁理論IB (Aクラス) 期末試験 2/3	2009年7月24日	学籍番号	氏名	評点
---------------------------	------------	------	----	----

2. 真空中に半径 a の円筒のシート状(厚さゼロ)の定常電流(表面電流密度 K)が流れている。 $K = i_z K$, であり, ここで, K [A/m] は一定, i_z は z 軸方向の基本ベクトルとする。以下に答えよ。

(2-1) アンペア・マクスウェルの法則(積分形)を記述し, その物理的意味を記述せよ。

$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$ (or $\oint_C \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \int_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$)

空間の任意の閉曲線(周回) C と C を積分路として磁界 $\mathbf{H}$ ($= \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}$) の接線成分 $\mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$ の周回積分すなわち起磁力(循環)の大きさ(左辺)は, その閉曲線 C (周回 C) と C の周辺とる面 S ($\mathbf{H}$ は $d\mathbf{l}$ と左ネジの関係にある面 S の法線ベクトル) と正味鎖交する導電電流と変位電流(電界密度の時間変化)に等しい。

(2-3) アンペア・マクスウェルの法則を示す積分形の方程式から微分形を導け。

アンペア・マクスウェルの法則を示す積分形は

$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$ (or $\oint_C \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \int_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$)

ストークスの定理より

$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \nabla \times \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$ $\therefore \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

(or $\nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \mathbf{J} + \frac{\partial \epsilon_0 \mathbf{E}}{\partial t}$)

(2-3) 上記のマクスウェル方程式(微分形)を用いて円柱内外の磁界 $\mathbf{H}$ を求めるとき, 解くべき微分方程式と境界条件を求めよ。

定常電流より $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 円柱座標系 (r, φ, z) より

$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\varphi} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_r & rH_\varphi & H_z \end{vmatrix} = \frac{1}{r} \left[\hat{r} \left\{ \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial (rH_\varphi)}{\partial z} \right\} + r\hat{\varphi} \left\{ \frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} \right\} + \hat{z} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} (rH_\varphi) - \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} \right\} \right]$

$= \hat{r} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} \right\} + \hat{\varphi} \left\{ \frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} \right\} + \hat{z} \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rH_\varphi) - \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} \right\} = \begin{cases} 0 & r < a \\ \hat{\varphi} K & r = a \\ 0 & r > a \end{cases}$

系の z 軸対称性より $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$, z 軸方向無限長の一様性が $\frac{\partial}{\partial z} = 0$, $\mathbf{H}$ は φ 成分 H_φ のみより

解くべき微分方程式は $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rH_\varphi) = \begin{cases} 0 & r < a \\ K & r = a \\ 0 & r > a \end{cases}$ $\mu_2 |a|$ ($\therefore H_{\varphi 1} - H_{\varphi 2} = K$)

$r=a$ で表面電流密度 $K = \hat{z} K$ より境界条件は $\rightarrow m=\hat{r} \therefore H_{1t} - H_{2t} = K$

$m \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = K \neq 0$ より $r=a$ で $\mathbf{H}$ の接線成分すなわち H_φ は K の分不連続。

(2-4) (2-3)より円柱内外の磁界 $\mathbf{H}$ を求めよ。また $|\mathbf{H}|$ の半径方向の分布を図示せよ。尚, 積分形から求めても良い。

i) $r < a$ の場合 (H2) ①②に (2-3) の境界条件を用いて

$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rH_\varphi) = 0$ $H_\varphi(r=a) = \frac{C_2}{a} - 0 = K$ $|\mathbf{H}| = H_\varphi$

$\frac{\partial}{\partial r} (rH_\varphi) = 0$ $\therefore C_2 = aK$ — ③

$rH_\varphi = C_1$ $\therefore H_\varphi = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{aK}{r} & r \geq a \end{cases}$

$r=0$ で H_φ は有限より $C_1 = 0$

$\therefore H_\varphi = 0$ — ①

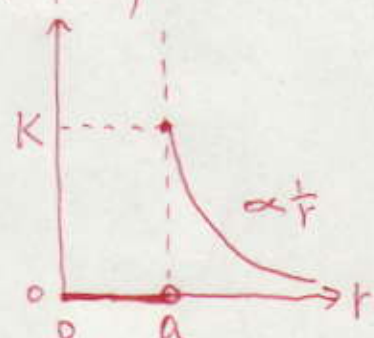
ii) $r > a$ の場合 (H1)

$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rH_\varphi) = 0$ $\therefore \mathbf{H} = \begin{cases} \hat{\varphi} 0 \text{ (or } 0) & r < a \\ \hat{\varphi} \frac{aK}{r} & r \geq a \end{cases}$

$\frac{\partial}{\partial r} (rH_\varphi) = 0$ $\therefore rH_\varphi = C_2$

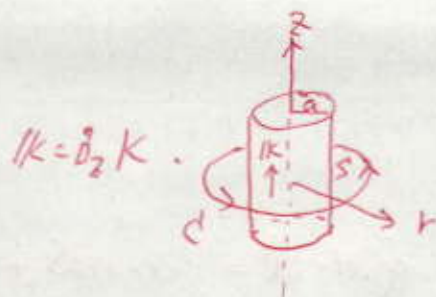
$\therefore H_\varphi = \frac{C_2}{r}$ — ②

$\left(\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \begin{cases} 0 & r < a \\ \hat{\varphi} \frac{\mu_0 a K}{r} & r \geq a \end{cases} \right)$



(2-4) 別解：積分形式を用いた方法

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$



z軸対称性 & z軸方向無限長で一般化

$\mathbf{H}$ は ϕ 方向成分 H_ϕ のみを持つ。 $\therefore \mathbf{H} = \hat{\phi} H_\phi$

$$d\mathbf{l}_\phi = \hat{\phi} r d\phi, \quad d\mathbf{S}_z = d\mathbf{l}_r \times d\mathbf{l}_\phi = \hat{r} dr \times \hat{\phi} r d\phi = \hat{z} r dr d\phi$$

$$\therefore \int_0^{2\pi} H_\phi r d\phi = \begin{cases} \int_0^{2\pi} \int_0^r 0 r dr d\phi = 0 & r < a \\ \int_0^{2\pi} K a d\phi & r > a \end{cases}$$

$$H_\phi r [\phi]_0^{2\pi} = \begin{cases} 0 & r < a \\ K a [\phi]_0^{2\pi} & r \geq a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \hat{\phi} H_\phi \cdot \hat{\phi} r d\phi &= \int_0^{2\pi} 0 \\ &= \int_0^{2\pi} \hat{z} K \cdot \hat{z} a d\phi \end{aligned}$$

$$\therefore H_\phi = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{Ka}{r} & r \geq a \end{cases} \quad \therefore \mathbf{H}_\phi = \begin{cases} 0 & r < a \\ \hat{\phi} \frac{Ka}{r} & r \geq a \end{cases}$$

$$\left(\frac{答}{\} \right) \text{全電流 } I = \oint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I = 2\pi a K \quad \therefore K = \frac{I}{2\pi a}$$

$$\therefore \mathbf{H} = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \hat{\phi} \frac{I}{2\pi r} & (r \geq a) \end{cases}$$

電磁理論IB (Aクラス) 期末試験 3/3	2009年7月24日	学籍番号	氏名	評点
---------------------------	------------	------	----	----

3. 次の問いに答えよ。

(3-1) シリコン(Si)内部にイオン注入によって電荷が注入されたとする。オームの法則 $J = \sigma E$ が成立するとき、電流電荷の保存則とマクスウェル方程式から電荷密度 ρ の時間発展を表す式と緩和時間 τ を示す一般的な式を導出し、 τ の値を求めよ。但し、 $t=0$ で $\rho = \rho_0$ とし、真空中の誘電率は $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ [F/m]、シリコンの比誘電率 $\epsilon_r = 12$ 、電気伝導率 $\sigma = 2.52 \times 10^{-4}$ [$m^{-1} \Omega^{-1}$] とする。数値は有効数字2桁まで記すこと。

電流電荷保存則より $\nabla \cdot J = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ ①

オームの法則 $J = \sigma E$ を代入 $\sigma \nabla \cdot E = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ ②

電場に因るガウスの法則 $\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ より $\frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ ③

③と②を代入 $\frac{\sigma}{\epsilon_0} \rho = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ $\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\rho} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} dt$ $\Rightarrow \ln \rho = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} t + C$ $\Rightarrow \rho = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\epsilon_0} t}$ $\tau = \frac{\epsilon_0}{\sigma} = \frac{12 \times 8.85 \times 10^{-12}}{2.52 \times 10^{-4}} = 4.2 \times 10^{-7}$ [sec]

(3-2) 電荷と電流が存在しない ($\rho=0, J=0$) の真空中の空間において伝播する電磁波のベクトル波動方程式を真空中のマクスウェル方程式から導出せよ。

$\rho=0, J=0$ の真空中におけるマクスウェル方程式は

① $\nabla \times E = -\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t}$ ② $\nabla \times H = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$ ③ $\nabla \cdot E = 0$ ④ $\nabla \cdot H = 0$

①の両辺の $\nabla \times$ をとり $\nabla \times (\nabla \times E) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times H)$ $\Rightarrow \nabla(\nabla \cdot E) - \nabla^2 E = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$ $\Rightarrow -\nabla^2 E = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$ $\Rightarrow \nabla^2 E = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$

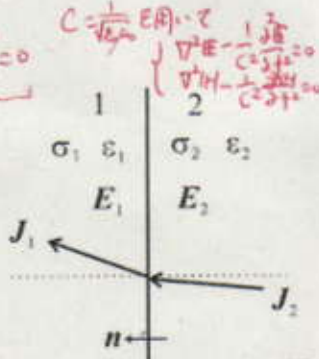
②の両辺の $\nabla \times$ をとり $\nabla \times (\nabla \times H) = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times E)$ $\Rightarrow \nabla(\nabla \cdot H) - \nabla^2 H = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 H}{\partial t^2}$ $\Rightarrow -\nabla^2 H = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 H}{\partial t^2}$ $\Rightarrow \nabla^2 H = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 H}{\partial t^2}$

(3-3) 誘電率が ϵ_1 、導電率が σ_1 なる媒質1と誘電率が ϵ_2 、導電率が σ_2 なる媒質2の境界面を横切って J なる電流密度の定常電流が流れているとき、この境界面に現れる自由電荷の密度 (面電荷密度 ξ) を求めよ。

オームの法則 $J = \sigma E$ より $J_1 = \sigma_1 E_1, J_2 = \sigma_2 E_2$

境界条件 $m \cdot (\nabla_1 - \nabla_2) = m \cdot (\epsilon_1 E_1 - \epsilon_2 E_2) = \xi$ $\Rightarrow m \cdot J_1 = m \cdot J_2 = J_n$

$\xi = \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} J_n - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} J_n = \left(\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \right) J_n$



(3-4) $y-z$ 方向無限に広い誘電体平板 (厚さ d) がこの平板に垂直な方向に一様に分極されている、すなわち、 $P = i_x P_0$ のとき、内部の分極電荷密度 ρ_p と分極電流電流 J_p 、表面の面分極電荷密度 ξ_p 、内部および外部の電界 E と電束密度 D を求めよ。

i) $\rho_p = -\nabla \cdot P = 0$

ii) $x=0$ で $P_1=0, P_2=P=\hat{i}_x P_0$ $\Rightarrow \xi_p(0) = -m \cdot (P_1 - P_2) = P_0$

$x=d$ で $P_1=0, P_2=P=\hat{i}_x P_0$ $\Rightarrow \xi_p(d) = P_0$

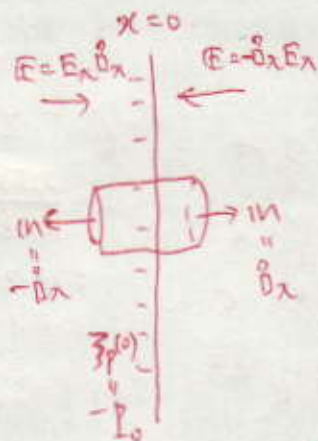
iii) $J_p = \frac{\partial P}{\partial t} = 0$

iv) 微分方程式 $\nabla \cdot \epsilon_0 E = \rho$ より $\nabla \cdot \epsilon_0 E = \rho_p + \rho_f$

$\frac{\partial}{\partial x} (\epsilon_0 E_x) = \rho_p + \rho_f$ $\Rightarrow E_x = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ -\frac{P_0}{\epsilon_0} & 0 < x < d \\ 0 & x > d \end{cases}$

v) $D = \epsilon_0 E + P = \hat{i}_x \left(-\frac{P_0}{2} + P_0 \right) = \hat{i}_x \frac{P_0}{2}$

(3-4) 別解: 積分形より $\oint_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \rho dV$



$$\epsilon_0 \mathbf{E} \cdot (-\mathbf{n}_x) dS + \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_x dS = \int_V \rho dV = -P_0 dS$$

面分極電荷
密度

$$\therefore -2\epsilon_0 E_x dS = -P_0 dS$$

$$\therefore E_x = \frac{P_0}{2\epsilon_0} \quad \therefore \mathbf{E} = \begin{cases} \mathbf{n}_x \frac{P_0}{2\epsilon_0} & x < 0 \\ -\mathbf{n}_x \frac{P_0}{2\epsilon_0} & x > 0 \end{cases}$$

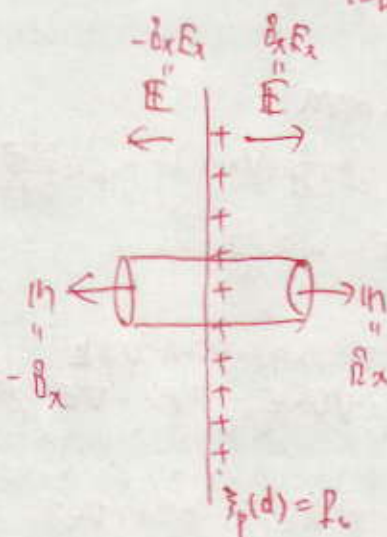
同様にして $x=d$ では

$$\epsilon_0 \mathbf{E} \cdot (-\mathbf{n}_x) dS + \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}_x dS = \int_V \rho dV = P_0 dS$$

$$\therefore 2\epsilon_0 E_x dS = P_0 dS$$

$$\therefore E_x = \frac{P_0}{2\epsilon_0}$$

$$\therefore \mathbf{E} = \begin{cases} -\mathbf{n}_x \frac{P_0}{2\epsilon_0} & x < d \\ \mathbf{n}_x \frac{P_0}{2\epsilon_0} & x > d \end{cases}$$



$x=0$ と $x=d$ の両面電荷の寄与を同時に考えよ

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \mathbf{n}_x \frac{P_0}{2\epsilon_0} + (-\mathbf{n}_x) \frac{P_0}{2\epsilon_0} = 0 & x < 0 \\ -\mathbf{n}_x \frac{P_0}{2\epsilon_0} + (-\mathbf{n}_x) \frac{P_0}{2\epsilon_0} = -\mathbf{n}_x \frac{P_0}{\epsilon_0} & 0 < x < d \\ -\mathbf{n}_x \frac{P_0}{2\epsilon_0} + \mathbf{n}_x \frac{P_0}{2\epsilon_0} = 0 & x > d \end{cases}$$

↑ ↑
 $x < 0$ $x < d$
寄与 "